

110 年度工研院 半導體、軟性電子及顯示技術等相關專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人（以下簡稱「國內廠商」）。

三、讓與標的：

本讓與案包含半導體、軟性電子及顯示技術等相關專利 141 案 266 件（以下簡稱「讓與標的」）。「讓與標的」共分為三個技術類別：（一）半導體技術（48 案 104 件）、（二）軟性電子技術（54 案 95 件）及（三）顯示技術（39 案 67 件）。「讓與標的」中之案次 50、121~122 係與第三人共有（以下簡稱「共有標的」）。請投標廠商留意：「讓與標的」中之案次 38 案，本次僅讓與 50%，得標廠商將與工研院平均共有該案專利；該案原為工研院與第三人共有之專利，該第三人已於民國（下同）109 年 11 月 13 日同意將其應有部分讓與工研院，使工研院為唯一權利人，現已完成專利移轉登記程序。「讓與標的」部份為科專成果，部分屬工研院自有成果。詳細情形請參「附件：讓與標的清單」。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於 110 年 3 月 4 日 15 時整於工研院中興院區 51 館 111 室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 110 年 3 月 2 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「**半導體、軟性電子及顯示技術等相關專利讓與案：公開說明會報名**」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話/分機、參與人數、姓名、職稱、參與人手機號碼。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十三、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 110 年 3 月 3 日 17 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日 110 年 3 月 29 日 17 時整（含）止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件(如公司登記證明文件、商業登記證明文件、公司設立核准函、公司登記／變更資料或公司設立登記表影本)、廠商基本資料表(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「半導體、軟性電子及顯示技術等相關專利讓與案」並標示出欲投標的技術類別(共三類，即「半導體技術」、「軟性電子技術」及「顯示技術」，詳如附件。但投標方式則以本條第2點公告之「一案一標」方式為之)，於截標日110年3月29日17時整(含)前(以送達收據為憑)掛號寄達或親送至：

310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

工研院技轉法律中心 林小姐 收

2. 本標案採「案」方式投標。「讓與標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、重要事項：

請投標人注意：「共有標的」係與第三人共有。故「共有標的」之讓與，須經共有人同意後，始生效力。

七、押標金：

1. 押標金為總投標金額之10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以轉帳、現金匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

八、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，

若於決標前未能補足者，其投標為無效。

九、決標方法：

1. 開標日為 110 年 3 月 30 日。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。
3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家（含）以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。
4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，該第三人以「國內廠商」且有參與投標者為優先。

十、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 30 個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，且該第三人以「國內廠商」且有參與投標者為優先。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，該第三人以「國內廠商」且有參與投標者為優先。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、貿易法及戰略性高科技貨品出口管制等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」經雙方依法簽章後，「讓與標的」中之科專成果，須報經濟部同意後生效。另，得標廠商充分了解「共有標的」之讓與，須經共有人同意。此外，工研院對於共有人及經濟部之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利，若經工研院要

求，得標廠商同意配合簽署授權同意書等予工研院。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。

9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：(1) 工研院已與第三人簽訂之授權契約；(2) 工研院已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及(3) 工研院已承諾不會對特定之人及特定產品行使專利權。得標廠商嗣後若擬將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，應依政府相關法令規定及「讓與契約書」約定，取得主管機關(包含但不限於經濟部技術處，以下同)核准及/或工研院同意後始得為之，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。
10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。
11. 「讓與標的」之讓與登記手續全權由工研院依工研院專利讓與登記作業規範辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。
12. 「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，為一切必要之申請，且得標廠商應於取得主管機關核准及/或工研院同意後，始得為下述行為：
 - (1) 得標廠商在我國管轄區域(係指台、澎、金、馬，下同)外自行

使用、實施者；

(2) 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

(3) 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

(4) 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。得標廠商為前述申請時，應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院，並應配合工研院向主管機關為一切必要之申請及提供一切相關之文件。

13. 得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得解除全部或部分「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」中之科專成果收歸國有：

(1) 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」中之科專成果，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

(2) 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」中之科專成果者。

(3) 為增進國家重大利益者。

得標廠商並同意，若違反「十、契約事項：」之第4、8、9、12、13、14、15及16項等約定者，工研院得逕將「讓與標的」過去、現在及未來之權利，非專屬授權予第三人，並保有相關之收益。

若有「十、契約事項：」第13項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，且經濟部及工研院均無須負擔任何損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人（以下稱「後手」）時，應依政府相關法令及「讓與契約書」約定，取得主管機關及/或工研院同意並將相關授權或讓與對象於授權或讓與前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。

15. 得標廠商應使所有「後手」遵守「十、契約事項：」之第8項至第10項、第12項至第17項之約定。得標廠商應與「後手」約定，如「後手」違反前述約定，工研院得直接對「後手」主張權利。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

16. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對第三人就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而

有必要採取法律行動時，應事先書面通知工研院，並取得工研院書面同意。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

- 17.得標廠商重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；有相當事實足證有發生前述情事之虞；或股權結構中增加陸、港、澳投資人，且陸、港、澳投資人持有之股份累計達全部股份百分之十以上（以下簡稱「股權變動」）時，工研院得以書面通知解除「讓與契約書」。得標廠商於「股權變動」情事發生後 30 日內，應以書面通知工研院；工研院僅得於該「股權變動」情事導致「讓與契約書」有違反政府法令規定或損及我國整體產業及技術發展之情況下，始得解除「讓與契約書」，或以書面另議新約。

十一、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人（請詳十三、聯絡方式）聯絡，取得投標單。

十二、注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本標案公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。工研院逕洽第三人之「讓與契約書」亦同。

十三、聯絡方式：本標案公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 林小姐

電話：+ 886-3-5916636

傳真：+886-3-5820466

電子信箱：iris.lin@itri.org.tw

地址：310401 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：「讓與標的」清單（共計 141 案 266 件）

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
半導體	記憶體	1	P51000001TW	非揮發性靜態隨機存取式記憶胞以及記憶體電路	獲證	台灣	發明專	科專	I429062	100120951	20140301	20310614		100%
半導體	記憶體		P51000001US	非揮發性靜態隨機存取式記憶胞以及記憶體電路	獲證	美國	發明專	科專	8,508,983	13/230,865	20130813	20310912		100%
半導體	記憶體	2	P51000034TW	非揮發性記憶體的寫入時序控制電路和控制方法	獲證	台灣	發明專	科專	I488192	100141040	20150611	20311109	非專屬授權中	100%
半導體	記憶體		P51000034US	非揮發性記憶體的寫入時序控制電路和控制方法	獲證	美國	發明專	科專	8,625,361	13/345,740	20140107	20320301	非專屬授權中	100%
半導體	記憶體	3	P51000073US	非揮發性隨機存取記憶體及其操作方法	獲證	美國	發明專	科專	8,422,295	13/332,402	20130416	20311220		100%
半導體	記憶體	4	P51990002TW	非揮發性靜態隨機存取記憶體及其操作方法	獲證	台灣	發明專	科專	I441185	99115131	20140611	20300511		100%
半導體	記憶體		P51990002US	非揮發性靜態隨機存取記憶體及其操作方法	獲證	美國	發明專	科專	8,331,134	12/853,301	20121211	20310512		100%
半導體	記憶體	5	P51000002US	記憶體單元	獲證	美國	發明專	科專	8,642,985	13/173,945	20140204	20311128		100%
半導體	記憶體	6	P51000008TW	電阻式記憶體及其寫入驗證方法	獲證	台灣	發明專	科專	I506627	100131032	20151101	20310829	非專屬授權中	100%
半導體	記憶體		P51000008US	電阻式記憶體及其寫入驗證方法	獲證	美國	發明專	科專	8,750,016	13/340,467	20140610	20321204	非專屬授權中	100%
半導體	記憶體	7	P51000047TW	非揮發性記憶體結構及其製造方法	獲證	台灣	發明專	科專	I462232	101113714	20141121	20320417	非專屬授權中	100%
半導體	記憶體		P51000047US	非揮發性記憶體結構及其製造方法	獲證	美國	發明專	科專	8,624,218	13/342,171	20140107	20320109	非專屬授權中	100%
半導體	記憶體	8	P51010009TW	電阻式隨機存取記憶體及其製造方法	獲證	台灣	發明專	科專	I458077	101119681	20141021	20320530		100%
半導體	記憶體	9	P51010038US	用於多圖案化的減光型相位移光罩	獲證	美國	發明專	科專	8,691,478	13/607,823	20140408	20320921		100%
半導體	記憶體	10	P51970106TW	多階記憶胞及其製造方法	獲證	台灣	發明專	科專	I441367	97140924	20140611	20281023		100%
半導體	記憶體	11	P51980067TW	控制方法	獲證	台灣	發明專	科專	I428929	98139877	20140301	20291123	非專屬授權中	100%
半導體	記憶體		P51980067US	控制方法	獲證	美國	發明專	科專	8,223,528	12/649,286	20120717	20300602	非專屬授權中	100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
半導體	記憶體		P51980067US C1	控制方法	獲證	美國	發明	科專	8,817,521	13/488,937	2014 0826	2030 0415	非專屬授權中	100%
半導體	記憶體	12	P51980077TW	電阻切換式記憶體	獲證	台灣	發明	科專	I405331	98145045	2013 0811	2029 1224		100%
半導體	記憶體		P51980077US	電阻切換式記憶體	獲證	美國	發明	科專	8,198,620	12/636,794	2012 0612	2030 0926	非專屬授權中	100%
半導體	記憶體	13	P51950004TW	磁穿隧元件及磁性記憶裝置	獲證	台灣	發明	科專	I307507	95138745	2009 0311	2026 1019		100%
半導體	記憶體		P51950004US	磁穿隧元件及磁性記憶裝置	獲證	美國	發明	科專	7,583,529	11/676,239	2009 0901	2027 0702		100%
半導體	記憶體	14	P51970116TW C1	磁自旋翻轉記憶體結構	獲證	台灣	發明	科專	I346335	98112550	2011 0801	2029 0414		100%
半導體	記憶體		P51970116US	磁自旋翻轉記憶體結構	獲證	美國	發明	科專	7,829,964	12/398,181	2010 1109	2029 0327		100%
半導體	記憶體		P51970116US D1	磁自旋翻轉記憶體結構	獲證	美國	發明	科專	8,026,562	12/883,188	2011 0927	2029 0304		100%
半導體	記憶體	15	P51990009TW	磁性隨機存取記憶體	獲證	台灣	發明	科專	I447726	99124007	2014 0801	2030 0720		100%
半導體	記憶體		P51990009US	磁性隨機存取記憶體	獲證	美國	發明	科專	8,421,171	12/960,559	2013 0416	2031 0810		100%
半導體	記憶體	16	P03940098TW	記憶體之負載平衡架構	獲證	台灣	發明	科專	I297155	94139805	2008 0521	2025 1110		100%
半導體	記憶體		P03940098US	記憶體之負載平衡架構	獲證	美國	發明	科專		11/347,052	2008 0610	2026 0202		100%
半導體	記憶體		P03940098CN	存儲器的負載平衡架構	獲證	中國	發明	科專	1988032	200510003537.4	2011 0622	2025 1222		100%
半導體	記憶體	17	P51950003TW	應用於記憶體之多穩態感測放大器	獲證	台灣	發明	科專	I312154	95126508	2009 0711	2026 0719		100%
半導體	記憶體		P51950003US	應用於記憶體之多穩態感測放大器	獲證	美國	發明	科專	7,539,068	11/797,725	2009 0526	2027 1023		100%
半導體	記憶體		P51950003CN	應用於存儲器的多穩態感測放大器	獲證	中國	發明	科專	101178927	200610143353.2	2010 0512	2026 1105		100%
半導體	記憶體	18	P51950018TW	應用於記憶體之多穩態感測放大器	獲證	台灣	發明	科專	I298886	95124607	2008 0711	2026 0705		100%
半導體	記憶體		P51950018US	應用於記憶體之多穩態感測放大器	獲證	美國	發明	科專	7,486,546	11/806,636	2009 0203	2027 0730		100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
半導體	記憶體		P51950018CN	應用於記憶體的多穩態讀出放大器	獲證	中國	發明	科專	100590735	200610121574.X	20100217	20260822		100%
半導體	生物感測器	19	P03910116TW	生物檢測器之奈米元件電晶體架構與製程	獲證	台灣	發明	科專	I253502	92123497	20060421	20230825		100%
半導體	生物感測器		P03910116US	生物檢測器之奈米元件電晶體架構與製程	獲證	美國	發明	科專		10/721,876	20070227	20240605		100%
半導體	SiC	20	P51000135TW	碳化矽溝槽式蕭基能障元件	獲證	台灣	發明	科專	I469341	101148717	20150111	20321219	曾非專屬授權	100%
半導體	SiC		P51000135US	碳化矽溝槽式蕭基能障元件	獲證	美國	發明	科專	8,766,279	13/727,432	20140701	20330108	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體電子構裝	21	P51990042US	測量裝置	獲證	美國	發明	科專	8,502,224	12/962,658	20130806	20310327		100%
半導體	半導體電子構裝		P51990042US C1	測量裝置	獲證	美國	發明	科專	8,507,909	13/308,523	20130813	20310327		100%
半導體	半導體電子構裝		P51990042CN	測量裝置	獲證	中國	發明	科專	102288335	201110160053.6	20140423	20310614		100%
半導體	半導體電子構裝	22	P51000113TW	晶片封裝結構	獲證	台灣	發明	科專	I463633	100149703	20141201	20311229		100%
半導體	半導體電子構裝		P51000113US	晶片封裝結構	獲證	美國	發明	科專	8,866,309	13/727,599	20141021	20330421		100%
半導體	半導體電子構裝		P51000113CN	芯片封裝結構	獲證	中國	發明	科專	103187372	201210567748.0	20160330	20321223		100%
半導體	半導體電子構裝	23	P51980023TW	整合熱電元件與晶片的封裝體	獲證	台灣	發明	科專	I407545	98127816	20130901	20290818		100%
半導體	半導體電子構裝		P51980023US	整合熱電元件與晶片的封裝體	獲證	美國	發明	科專	8,546,924	12/849,774	20131001	20310827		100%
半導體	半導體電子構裝		P51980023CN	整合熱電組件與芯片的封裝體	獲證	中國	發明	科專	102034805	200910178643.4	20121226	20290923		100%
半導體	半導體電子構裝	24	P51990083TW	半導體裝置	獲證	台灣	發明	科專	I441305	99144951	20140611	20301220		100%
半導體	半導體電子構裝		P51990083US	半導體裝置	獲證	美國	發明	科專	8,674,491	13/103,107	20140318	20311026		100%
半導體	半導體電子構裝	25	P51960004TW	具可拉伸性之軟性電路結構及其製造方法	獲證	台灣	發明	科專	I339087	96113690	20110311	20270417	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體電子構裝		P51960004US D1	具可拉伸性之軟性電路結構及其製造方法	獲證	美國	發明	科專	8,513,532	13/033,385	20130820	20271104	曾非專屬授權	100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
半導體	半導體電子構裝	26	P51000118TW	固態電解電容基板模組及包括該固態電解電容基板模組的電路板	獲證	台灣	發明專		I483352	101108286	20150501	20320311		100%
半導體	半導體電子構裝		P51000118US	固態電解電容基板模組及包括該固態電解電容基板模組的電路板	獲證	美國	發明專		9,030,808	13/607,820	20150512	20330611		100%
半導體	半導體電子構裝		P51000118CN	固態電解電容基板模塊及包括其的電路板	獲證	中國	發明專		103310990	201210139386.5	20161207	20320506		100%
半導體	半導體電子構裝	27	P51010096TW	螺旋電感結構	獲證	台灣	發明專		I462126	101150891	20141121	20321227		100%
半導體	半導體電子構裝	28	P51950016TW	互補鏡像式內藏平面電阻架構	獲證	台灣	發明自有		I370708	95138693	20120811	20261019		100%
半導體	半導體電子構裝		P51950016US	互補鏡像式內藏平面電阻架構	獲證	美國	發明自有		8,035,036	11/861,297	20111011	20290418		100%
半導體	半導體電子構裝	29	P51960111TW	靜電放電防護架構	獲證	台灣	發明專		I421996	97100969	20140101	20280109		100%
半導體	半導體電子構裝		P51960111US	靜電放電防護架構	獲證	美國	發明專		7,894,172	12/191,179	20110222	20281224		100%
半導體	半導體電子構裝	30	P51990051TW	內埋式電子元件之封裝結構	獲證	台灣	發明專		I472007	99146374	20150201	20301227		100%
半導體	半導體電子構裝	31	P51990048TW	封裝單元及其堆疊結構與製造方法	獲證	台灣	發明專		I501365	99134969	20150921	20301012		100%
半導體	半導體電子構裝		P51990048US	封裝單元及其堆疊結構與製造方法	獲證	美國	發明專		8,502,378	13/272,771	20130806	20311225		100%
半導體	半導體電子構裝	32	P03910069TW	自組裝奈米導電凸塊及其製造方法	獲證	台灣	發明專		582104	91132880	20040401	20221107	非專屬授權中	100%
半導體	半導體電子構裝		P03910069US	自組裝奈米導電凸塊及其製造方法	獲證	美國	發明專			10/653,860	20060124	20230902	非專屬授權中	100%
半導體	半導體光源	33	P51000007US	發光元件及發光元件的製作方法	獲證	美國	發明專		8,587,017	13/070,486	20131119	20300503		100%
半導體	半導體光源	34	P51030025TW	半導體發光結構	獲證	台灣	發明專		I572061	103143016	20170221	20341209		100%
半導體	半導體光源	35	P51970058TW	磁性發光裝置	獲證	台灣	發明專		I464901	98121407	20141211	20290624	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源		P51970058US	磁性發光裝置	獲證	美國	發明專		7,989,818	12/146,422	20110802	20290626	曾非專屬授權	100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
半導體	半導體光源	36	P51970087TW	磁性發光元件	獲證	台灣	發明	科專	1412156	97148270	20131011	20281210	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源		P51970087US	磁性發光元件	獲證	美國	發明	科專	7,858,991	12/351,815	20101228	20280517	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源		P51970087CND1	發光裝置	獲證	中國	發明	科專	103208569	PCT/CN2008/201310140372.X	20151104	20281225		100%
半導體	半導體光源		P51970087JPD1	磁性發光元件	獲證	日本	發明	科專	5564129	PCT/CN2008/2013-049968	20140620	20281225		100%
半導體	半導體光源		P51970087KR	磁性發光元件	獲證	韓國	發明	科專	10-1200874	PCT/CN2008/10-2010-7017768	20121107	20281225		100%
半導體	半導體光源	37	P51980005TW	發光裝置	獲證	台灣	發明	科專	1478374	98115415	20150321	20290507	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源		P51980005US	發光裝置	獲證	美國	發明	科專	7,928,463	12/436,798	20110419	20280710	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源		P51980005CN	發光裝置	獲證	中國	發明	科專	101577306	200910203009.1	20120104	20290507	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源	38	P51070038EP	光源裝置	審查中	歐盟	發明	自有		EP18179703.6				50%
半導體	半導體光源		P51070038JP	光源裝置	獲證	日本	發明	自有	6707219	2018-121268	20200522	20380625		50%
半導體	半導體光源	39	P51070044TW	光照護系統以及光照護方法	審查中	台灣	發明	自有		107140149				100%
半導體	半導體光源		P51070044US	光照護系統以及光照護方法	審查中	美國	發明	自有		16/232,065				100%
半導體	半導體光源	40	P51010099TW	光源裝置	獲證	台灣	發明	科專	1576010	101151048	20170321	20321227	非專屬授權中、曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源		P51010099TWC1	光源裝置及顯示裝置	獲證	台灣	發明	科專	1683596	107121837	20200121	20380625		100%
半導體	半導體光源		P51010099US	光源裝置	獲證	美國	發明	科專	9,095,029	13/864,235	20150728	20340110	非專屬授權中、曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源		P51010099USC1	光源裝置	獲證	美國	發明	科專	9,693,408	14/746,857	20170627	20330415	曾非專屬授權	100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
半導體	半導體光源		P51010099US C2	光源裝置	獲證	美國	發明	科專	10,039,169	15/632,393	2018 0731	2033 0415	非專屬授權中、 曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源		P51010099US C3	光源裝置及顯示裝置	獲證	美國	發明	科專	10,485,070	16/018,086	2019 1119	2033 0415		100%
半導體	半導體光源		P51010099CN	光源裝置及照明裝置	獲證	中國	發明	科專	103906309	201310736811.3	2016 0706	2033 1226	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源		P51010099CN C1	光源裝置及顯示裝置	獲證	中國	發明	科專	109121243	201810672645.8	2020 0915	2038 0625		100%
半導體	半導體光源		P51010099CN D1	光源裝置及照明裝置	獲證	中國	發明	科專	106028583	201610339601.4	2018 1123	2033 1226		100%
半導體	半導體光源	41	P51060041TW	燈具控制方法、燈具控制裝置 及電腦程式產品	獲證	台灣	發明	科專	1665939	106144652	2019 0711	2037 1218	非專屬授權中	100%
半導體	半導體光源		P51060041US	燈具控制方法、燈具控制裝置 及電腦程式產品	獲證	美國	發明	科專	10,271,410	15/974,673	2019 0423	2038 0507		100%
半導體	半導體光源	42	P51000097TW	照明控制裝置和方法	獲證	台灣	發明	自有	1459330	100149454	2014 1101	2031 1228		100%
半導體	半導體光源	43	P51990116TW	具有多功能用途的照明系統及 其控制方法	獲證	台灣	發明	科專	1545990	100103720	2016 0811	2031 0130	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源		P51990116US	具有多功能用途的照明系統及 其控制方法	獲證	美國	發明	科專	8,847,508	13/237,775	2014 0930	2032 0807	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源		P51990116US C1	具有多功能用途的照明系統及 其控制方法	獲證	美國	發明	科專	9,578,709	14/485,886	2017 0221	2031 0919	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源		P51990116US C2	具有多功能用途的照明系統及 其控制方法	獲證	美國	發明	科專	9,900,956	14/979,925	2018 0220	2031 0919	曾非專屬授權	100%
半導體	半導體光源	44	P51970061TW	發光裝置與其製造方法	獲證	台灣	發明	科專	1447892	98113013	2014 0801	2029 0419		100%
半導體	半導體光源		P51970061US	發光裝置與其製造方法	獲證	美國	發明	科專	8,310,037	12/545,862	2012 1113	2031 0205		100%
半導體	半導體光源	45	P51960104US	發光模組	獲證	美國	發明	科專	8,777,437	12/046,419	2014 0715	2031 1025		100%
半導體	半導體光源	46	P51010151TW	發光二極體元件與發光二極體 元件的製造方法	獲證	台灣	發明	科專	1497771	102112711	2015 0821	2033 0409		100%
半導體	半導體光源	47	P51010169TW	發光二極體晶圓及其製造方法	獲證	台灣	發明	科專	1513051	102116428	2015 1211	2033 0507		100%
半導體	半導體光源	48	P51020059US D1	發光二極體封裝結構	獲證	美國	發明	科專	9,231,168	14/267,919	2016 0105	2034 0501		100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
軟性電子	軟性感測器	49	P51990131US	投射式電容觸控感應器結構	獲證	美國	發明	科專	8,450,628	13/175,897	20130528	20320102		100%
軟性電子	軟性感測器		P51990131CN	投射式電容觸控感應器結構及其製造方法	獲證	中國	發明	科專	102622145	201110234263.5	20150513	20310811		100%
軟性電子	軟性感測器	50	P61990050TWC1	用以感測施力之感測裝置	獲證	台灣	發明	科專	I461668	100130380	20141121	20310823	共有	100%
軟性電子	軟性感測器	51	P51000123US	壓力感測器的電性量測裝置及其方法	獲證	美國	發明	科專	8,776,607	13/423,294	20140715	20321110	曾非專屬授權	100%
軟性電子	軟性揚聲器	52	P51950201TW	靜電電聲轉換器	獲證	台灣	發明	科專	I331881	96145009	20101011	20271126	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51950201US	靜電電聲轉換器	獲證	美國	發明	科專	8,081,784	11/849,645	20111220	20301018	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51950201CN	靜電電聲轉換器	獲證	中國	發明	科專	101384102	200710160549.7	20121114	20271224	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	53	P51960065TW	揚聲器單體結構	獲證	台灣	發明	科專	I330500	96132878	20100911	20270903	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51960065US	揚聲器單體結構	獲證	美國	發明	科專	8,107,651	12/187,381	20120131	20301015	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51960065CN	揚聲器單體結構	獲證	中國	發明	科專	101426165	200710184913.3	20130320	20271028	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	54	P51960066TW	靜電式揚聲器結構與其製造方法	獲證	台灣	發明	科專	I340602	96133208	20110411	20270905	非專屬授權中、曾非專屬授權	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51960066US	靜電式揚聲器結構與其製造方法	獲證	美國	發明	科專	8,155,356	12/175,467	20120410	20301220	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	55	P51960167TW	可撓曲電聲組合結構、揚聲器及該組件製造方法	獲證	台灣	發明	科專	I330501	97120995	20100911	20280604	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51960167US	可撓曲電聲組合結構、揚聲器及該組件製造方法	獲證	美國	發明	科專	8,138,034	12/185,827	20120320	20301207	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	56	P51970025TW	揚聲器單體結構	獲證	台灣	發明	科專	I367034	97129296	20120621	20280731	非專屬授權中、曾非專屬授權	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51970025US	揚聲器單體結構	獲證	美國	發明	科專	8,139,794	12/370,598	20120320	20300807	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51970025CN	揚聲器單體結構	獲證	中國	發明	科專	101656906	200810211084.8	20130123	20280819	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	57	P51970026TW	揚聲器的製造方法	獲證	台灣	發明	科專	I352547	98111488	20111111	20290406	非專屬授權中	100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
軟性電子	軟性揚聲器		P51970026US	揚聲器的製造方法	獲證	美國	發明	科專	8,196,282	12/370,599	20120612	20291122	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51970026CN	揚聲器的製造方法	獲證	中國	發明	科專	101729972	200910141110.9	20131016	20290521	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	58	P51970027TW	揚聲器	獲證	台灣	發明	科專	I376964	97135240	20121111	20280911	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51970027US	揚聲器	獲證	美國	發明	科專	8,300,859	12/427,750	20121030	20310703	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51970027CN	揚聲器	獲證	中國	發明	科專	101715159	200810166128.X	20130807	20281007	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	59	P51970047TW	駐極體揚聲器單體的電極連接結構	獲證	台灣	發明	科專	I368445	97130533	20120711	20280810	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51970047US	駐極體揚聲器單體的電極連接結構	獲證	美國	發明	科專	8,280,081	12/344,270	20121002	20310211	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51970047CN	揚聲器單體的電極連接結構	獲證	中國	發明	科專	101668240	200810212834.3	20130206	20280904	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	60	P51970126TW	多面向平面式揚聲器裝置	獲證	台灣	發明	科專	I399987	98104651	20130621	20290212	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51970126US	多面向平面式揚聲器裝置	獲證	美國	發明	科專	8,126,189	12/472,379	20120228	20300331	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	61	P51970157TW C1	平面揚聲器單體與揚聲器裝置	獲證	台灣	發明	科專	I342165	98117344	20110511	20290524	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51970157US	平面揚聲器單體與揚聲器裝置	獲證	美國	發明	科專	8,391,520	12/541,145	20130305	20311215	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51970157CN	平面揚聲器單體與揚聲器裝置	獲證	中國	發明	科專	101729965	200910202828.4	20130403	20290525	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	62	P51980009US	靜電式揚聲器	獲證	美國	發明	科專	8,594,349	12/649,330	20131126	20320926	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	63	P51980010TW	平面揚聲器結構	獲證	台灣	發明	科專	I343756	98126821	20110611	20290809	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51980010US	平面揚聲器結構	獲證	美國	發明	科專	8,385,586	12/759,710	20130226	20310615	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	64	P51980022TW	揚聲器的製造方法與裝置	獲證	台灣	發明	科專	I419577	98144545	20131211	20291222	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51980022US	揚聲器的製造方法與裝置	獲證	美國	發明	科專	8,322,018	12/717,956	20121204	20300721	非專屬授權中	100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
軟性電子	軟性揚聲器		P51980022CN	揚聲器的製造方法與裝置	獲證	中國	發明專	科專	102118679	200910266096.5	20131106	20291230	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	65	P51990077US	平面揚聲器單體及平面揚聲器裝置	獲證	美國	發明專	科專	8,625,824	12/979,341	20140107	20290225	非專屬授權中	100%
軟性電子	軟性揚聲器	66	P51980104TW	具有光能轉換的電聲裝置	獲證	台灣	發明專	科專	1437892	99123272	20140511	20300714		100%
軟性電子	軟性揚聲器		P51980104US	具有光能轉換的電聲裝置	獲證	美國	發明專	科專	8,831,253	12/909,840	20140909	20310818		100%
軟性電子	軟性揚聲器	67	P51990057US	平面揚聲器的驅動介面裝置	獲證	美國	發明專	科專	8,588,438	12/981,508	20131119	20310915		100%
軟性電子	軟性太陽能元件	68	P51980029TW	半透明太陽光電膜	獲證	台灣	發明專	科專	1415274	98130062	20131111	20290906		100%
軟性電子	軟性太陽能元件	69	P51990085TW	有機反式太陽能元件	獲證	台灣	發明專	科專	1433370	99141046	20140401	20301125		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	70	P51040060US	發光裝置的驅動系統及驅動方法	獲證	美國	發明專	科專	10,117,305	15/260,335	20181030	20360908	曾非專屬授權	100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51040060CN C1	平面有機電致發光裝置的驅動系統及驅動方法	獲證	中國	發明專	科專	107426854	201710321108.4	20190514	20370508	曾非專屬授權	100%
軟性電子	有機照明元件與模組	71	P51020046TW	發光二極體結構	獲證	台灣	發明專	科專	1563704	102149249	20161221	20331230		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	72	P51020047TW	發光模組	獲證	台灣	發明專	科專	1513061	102146202	20151211	20331212		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	73	P51020079US	一種照明模組	獲證	美國	發明專	科專	9,224,790	14/447,152	20151229	20340729		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51020079US C1	一種照明模組	獲證	美國	發明專	科專	9,395,072	14/819,035	20160719	20340729		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	74	P51030008TW	有機發光元件	獲證	台灣	發明專	科專	1536630	103141354	20160601	20341127		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	75	P51030010TW	有機發光模組	獲證	台灣	發明專	科專	1552410	104120511	20161001	20350624		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51030010US	有機發光模組	獲證	美國	發明專	科專	9,570,712	14/447,626	20170214	20340730		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51030010CN	有機發光模塊	獲證	中國	發明專	科專	105322097	201510446017.4	20170707	20350726		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	76	P51030018US	一種異質接面式載子產生結構	獲證	美國	發明專	科專	9,356,249	14/501,029	20160531	20340929		100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
軟性電子	有機照明元件與模組	77	P51030023TW	有機發光二極體照明模組與裝置	獲證	台灣	發明專	科專	I637654	104121018	20181001	20350629	曾非專屬授權	100%
軟性電子	有機照明元件與模組	78	P51030057TW	發光元件、電極結構與其製作方法	獲證	台灣	發明專	科專	I553933	104120972	20161011	20350628		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51030057US	發光元件、電極結構與其製作方法	獲證	美國	發明專	科專	9,680,123	14/953,430	20170613	20351129		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51030057CN	發光元件、電極結構與其製作方法	獲證	中國	發明專	科專	105702875	201510513091.3	20180427	20350819		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	79	P51040018US	一種通用型可變色溫及亮度的OLED 控制系統	獲證	美國	發明專	科專	9,741,956	14/864,910	20170822	20350928	曾專屬授權	100%
軟性電子	有機照明元件與模組	80	P51040021TW	發光元件及發光元件的製造方法	獲證	台灣	發明專	科專	I565120	104139123	20170101	20351124		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51040021US	發光元件及發光元件的製造方法	獲證	美國	發明專	科專	10,084,135	14/949,905	20180925	20351123		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	81	P51040026US	有機發光裝置	獲證	美國	發明專	科專	9,865,671	15/255,156	20180109	20360901		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51040026CN	有機發光裝置	獲證	中國	發明專	科專	106505083	201610316537.8	20190614	20360512		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	82	P51040027TW	封裝膜材與電子元件封裝體	獲證	台灣	發明專	科專	I565118	104138194	20170101	20351118		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	83	P51040039US	一種可將 OLED 導入 R2R 製程之結構	獲證	美國	發明專	科專	9,882,173	14/953,428	20180130	20351129		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	84	P51040040TW	發光元件	獲證	台灣	發明專	科專	I568036	104138827	20170121	20351122		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51040040US	發光元件	獲證	美國	發明專	科專	9,923,135	15/293,298	20180320	20361013		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51040040CN	發光組件	獲證	中國	發明專	科專	106784342	201610278151.2	20180921	20360428		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	85	P51040062US	有機電致發光裝置及其製造方法	獲證	美國	發明專	自有	9,887,359	15/080,560	20180206	20351129		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51040062CN	有機電致發光裝置及其製造方法	獲證	中國	發明專	自有	106025100	201610195135.7	20180123	20360330		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	86	P51040064US	一種 OLED 照明的新型包封形式封裝	獲證	美國	發明專	科專	9,614,187	15/084,463	20170404	20360328	非專屬授權中	100%
軟性電子	有機照明元件與模組	87	P51050010TW	有機發光二極體之製作方法及其結構	獲證	台灣	發明專	科專	I595695	105129889	20170811	20360912		100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
軟性電子	有機照明元件與模組	88	P51050027TW	可撓性有機發光二極體的結構及其製造方法	獲證	台灣	發明專		I630742	105129898	20180721	20360913		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	89	P51050035TW	驅動模組、及具有此驅動模組的光源系統	獲證	台灣	發明專		I613932	105139870	20180201	20361201	曾非專屬授權	100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51050035US	驅動模組、及具有此驅動模組的光源系統	獲證	美國	發明專		10,051,712	15/394,819	20180814	20361229	曾非專屬授權	100%
軟性電子	有機照明元件與模組	90	P51050036TW	有機發光二極體和白光有機發光二極體	獲證	台灣	發明專		I611612	105139559	20180111	20361129		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51050036US	有機發光二極體和白光有機發光二極體	獲證	美國	發明專		10,622,576	15/451,427	20200414	20380602		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51050036CN	有機發光二極管和白光有機發光二極體	獲證	中國	發明專		108123047	201710133511.4	20200619	20370307		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	91	P51050040TW	有機電激發光元件	獲證	台灣	發明專		I630740	105133991	20180721	20361020		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	92	P51050049TW	有機電激發光元件以及可撓性電子元件的製造方法	獲證	台灣	發明專		I600347	105139199	20170921	20361128		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51050049US	有機電激發光元件以及可撓性電子元件的製造方法	獲證	美國	發明專		9,991,478	15/361,004	20180605	20351129		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	93	P51050068TW	發光元件與發光元件的製造方法	獲證	台灣	發明專		I638473	105140356	20181011	20361206		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51050068US	發光元件與發光元件的製造方法	獲證	美國	發明專		10,249,803	15/455,146	20190402	20370314		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	94	P51050077US	利用激發複合體製作高效率及低效率滾降白光照明元件	獲證	美國	發明專		10,276,801	15/414,638	20190430	20370719		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	95	P51050083TW	有機發光元件	獲證	台灣	發明專		I660535	106109464	20190521	20370321		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	96	P51050093TW	有機光電元件及有機光電模組	獲證	台灣	發明專		I641168	106117094	20181111	20370523		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	97	P51060001TW	有機發光元件的驅動模組以及驅動方法	獲證	台灣	發明專		I631546	106116300	20180801	20370516	曾非專屬授權	100%
軟性電子	有機照明元件與模組	98	P51060012TW	薄膜以及有機發光元件的製造方法	獲證	台灣	發明專		I650618	106134108	20190211	20371002		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	99	P51060049US	阻水氣功能性基板	審查中	美國	發明專			16/231,959			非專屬授權中	100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
軟性電子	有機照明元件與模組	100	P51060053TW	發光元件	獲證	台灣	發明	科專	I667820	107111083	20190801	20380329		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51060053US	發光元件	獲證	美國	發明	科專	10,445,564	16/178,617	20191029	20381101		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51060053CN	發光組件	審查中	中國	發明	科專		201811002380.7				100%
軟性電子	有機照明元件與模組	101	P51070014TW	有機電激發光元件的製造方法	獲證	台灣	發明	科專	I682565	107127453	20200111	20380806		100%
軟性電子	有機照明元件與模組	102	P51070034TW	有機半導體裝置、驅動裝置以及驅動方法	獲證	台灣	發明	科專	202022839	107144887	20200821	20381211		100%
軟性電子	有機照明元件與模組		P51070034CN	有機半導體裝置、驅動裝置以及驅動方法	審查中	中國	發明	科專		201811612272.1				100%
顯示	薄膜電晶體液晶顯示器	103	034900028TW	具垂直結構之薄膜電晶體	獲證	台灣	發明	科專	527712	91100347	20030411	20220110	非專屬授權中、曾非專屬授權	100%
顯示	薄膜電晶體液晶顯示器	104	034900066TW	形成薄膜電晶體於透明基板上的方法	獲證	台灣	發明	科專	516240	91102658	20030101	20220217	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體液晶顯示器		034900066US	形成薄膜電晶體於透明基板上的方法	獲證	美國	發明	科專		10/152,671	20040720	20221128	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體液晶顯示器		034900066US C1	形成薄膜電晶體於透明基板上的方法	獲證	美國	發明	科專		10/793,916	20050301	20240307	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體液晶顯示器		034900066US C2	形成薄膜電晶體於透明基板上的方法	獲證	美國	發明	科專		10/845,102	20050301	20240513	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體液晶顯示器	105	034910035TW	形成薄膜電晶體元件的方法以及形成薄膜電晶體元件於彩色濾光片上的方法	獲證	台灣	發明	科專	559896	91136408	20031101	20221216	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體液晶顯示器	106	P03910118TW	多層互補式導線結構及其製造方法	獲證	台灣	發明	科專	I220775	92127501	20040901	20231002		100%
顯示	薄膜電晶體液晶顯示器	107	P03940178TW	基板結構、液晶顯示器及液晶顯示器的製造方法	獲證	台灣	發明	科專	I315435	94145525	20091001	20251220	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體液晶顯示器		P03940178US	基板結構、液晶顯示器及液晶顯示器的製造方法	獲證	美國	發明	科專	7,528,916	11/404,288	20090505	20271030	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體液晶顯示器	108	034910043TW	橫向驅動電場之廣視角液晶顯示器及其製作方法	獲證	台灣	發明	科專	594234	91134946	20040621	20221201	非專屬授權中	100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器		034910043US	橫向驅動電場之廣視角液晶顯示器及其製作方法	獲證	美國	發明專			10/448,669	2004 1207	2023 0528	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器	109	034910060TW	改善週期性電極排列引發光繞射效應之結構及液晶顯示裝置	獲證	台灣	發明專	554223	92100124		2003 0921	2023 0102	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器		034910060US	改善週期性排列引發光繞射效應之結構及液晶顯示裝置	獲證	美國	發明專			10/660,575	2005 1220	2024 0106	非專屬授權中、 曾非專屬授權	100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器	110	P03910111TW	利用 TiO ₂ 層製作擴散式反射板	獲證	台灣	發明專	594325	92107808		2004 0621	2023 0403	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器	111	034900027TW	傾斜散射反射板的製造方法與結構	獲證	台灣	發明專	I245953	90120182		2005 1221	2021 0816	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器		034900027US	傾斜散射反射板的製造方法與結構	獲證	美國	發明專			09/988,057	2004 0217	2022 0213	非專屬授權中、 曾非專屬授權	100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器	112	034900071TW	利用灰階曝光法製作傾斜散射式反射板之方法	獲證	台灣	發明專	552467	91105554		2003 0911	2022 0321	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器		034900071US	利用灰階曝光法製作傾斜散射式反射板之方法	獲證	美國	發明專			10/140,252	2004 0810	2022 0910	非專屬授權中、 曾非專屬授權	100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器	113	034910063TW	具有不同夾厚的半穿透式液晶顯示器裝置及其製造方法	獲證	台灣	發明專	594235	91136407		2004 0621	2022 1216	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器		034910063US	具有不同夾厚的半穿透式液晶顯示器裝置及其製造方法	獲證	美國	發明專			10/622,795	2005 0322	2023 1001	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器	114	P03920020TW	塑膠基板彩色濾光片製造方法	獲證	台灣	發明專	594423	92123828		2004 0621	2023 0827	非專屬授權中	100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器	115	P51000062TW	混合多工式立體顯示器及混合多工式立體影像之顯示方法	獲證	台灣	發明專	1471607	101111125		2015 0201	2032 0328		100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器		P51000062US	混合多工式立體顯示器及混合多工式立體影像之顯示方法	獲證	美國	發明專	9,116,357	13/334,026		2015 0825	2028 0828		100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器		P51000062CN	混合多工式立體顯示器及其顯示方法	獲證	中國	發明專	103176277	201210175449.2		2016 0120	2032 0530		100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器	116	P51000138CN	顯示裝置及其控制方法	獲證	中國	發明專	103383493	201210227897.2		2016 0914	2032 0701		100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器	117	P51010117CN	立體顯示設備	獲證	中國	發明專	103728769	201310274657.2		2016 0810	2033 0701		100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器	118	P51020061TW	時間多工之掃描裝置及立體顯示裝置	獲證	台灣	發明專	I514850	102144166		2015 1221	2033 1202		100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器	119	P51950040TW	立體影像顯示裝置以及降低立體影像干擾的方法	獲證	台灣	發明專	I363192	95130046		2012 0501	2026 0815		100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器		P51950040US	立體影像顯示裝置以及降低立體影像干擾的方法	獲證	美國	發明專	科專	8,786,539	11/672,521	2014 0722	2031 1224		100%
顯示	薄膜電晶體 液晶顯示器		P51950040CN	立體圖像顯示裝置以及降低立體圖像干擾的方法	獲證	中國	發明專	科專	101137071	200610125698.5	2010 0929	2026 0830		100%
顯示	主動式軟 性顯示	120	P61000069TW	感測裝置及其驅動方法	獲證	台灣	發明專	科專	1452520	100148923	2014 0911	2031 1226		100%
顯示	主動式軟 性顯示		P61000069US	感測裝置及其驅動方法	獲證	美國	發明專	科專	9,256,306	13/439,871	2016 0209	2033 0219		100%
顯示	主動式軟 性顯示	121	P61970034TW	感測面板	獲證	台灣	發明專	科專	1412974	97146035	2013 1021	2028 1126	共有	100%
顯示	主動式軟 性顯示	122	P61990027TW	軟性顯示面板及其組裝方法	獲證	台灣	發明自 有		1476738	99130232	2015 0311	2030 0906	共有	100%
顯示	主動式軟 性顯示		P61990027US	軟性顯示面板及其組裝方法	獲證	美國	發明自 有		9,230,467	13/105,896	2016 0105	2033 0331	共有	100%
顯示	主動式軟 性顯示		P61990027CN	軟性顯示面板及其組裝方法	獲證	中國	發明自 有		102446926	201010504254.9	2014 0903	2030 1007	共有	100%
顯示	主動式軟 性顯示	123	P51990013TW	畫素驅動電路及畫素驅動方法	獲證	台灣	發明專	科專	1423214	99122173	2014 0111	2030 0705		100%
顯示	反射式 顯示	124	P61010088TW	電子資訊顯示牌	獲證	台灣	新型自 有		M470978	102214421	2014 0121	2023 0730		100%
顯示	反射式 顯示		P61010088CN	電子信息顯示牌	獲證	中國	新型自 有		203490903	201320604619.4	2014 0319	2023 0926		100%
顯示	反射式 顯示	125	P61960042US	彩色膽固醇液晶顯示器裝置及其製造方法	獲證	美國	發明專	科專	8,264,642	12/268,176	2012 0911	2031 0612	曾專屬授權	100%
顯示	反射式 顯示	126	P61990036US	一種含微共振腔結構之彩色膽固醇液晶面板	獲證	美國	發明專	科專	8,704,996	13/092,896	2014 0422	2032 1008		100%
顯示	反射式 顯示	127	P61010074TW	顯示裝置	獲證	台灣	發明專	科專	1526320	102121856	2016 0321	2033 0619	非專屬授權中、 曾專屬授權	100%
顯示	反射式 顯示	128	P61020015TW	電濕潤顯示器及其基板的製作方法、設備、組立設備與系統	獲證	台灣	發明專	科專	1502217	102149304	2015 1001	2033 1230	非專屬授權中、 曾專屬授權	100%
顯示	反射式 顯示		P61020015CN	電濕潤顯示器及基板的製作方法、設備、組立設備與系統	獲證	中國	發明專	科專		201410068784.1	2017 0412	2034 0226	非專屬授權中、 曾專屬授權	100%
顯示	取像與 影像處理 技術	129	P51000078TW	頭戴式個人電腦及其互動式系統	獲證	台灣	發明自 有		1437464	100146907	2014 0511	2031 1215		100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
顯示	取像與影像處理技術		P51000078US	頭戴式個人電腦及其互動式系統	獲證	美國	發明	自有	8,970,692	13/410,305	20150303	20330530		100%
顯示	取像與影像處理技術	130	P51980110TW	動畫產生系統及方法	獲證	台灣	發明	科專	1434227	99110520	20140411	20300405		100%
顯示	取像與影像處理技術		P51980110US	動畫產生系統及方法	獲證	美國	發明	科專	8,462,198	12/941,098	20130611	20310823		100%
顯示	取像與影像處理技術	131	P08940030TW	利用平面過濾限制之快速影像空間關係建構方法	獲證	台灣	發明	科專	1273509	94131432	20070211	20250912		100%
顯示	取像與影像處理技術		P08940030US	利用平面過濾限制之快速影像空間關係建構方法	獲證	美國	發明	科專	7,751,613	11/393,190	20100706	20290505		100%
顯示	取像與影像處理技術	132	P51950128TW	基於三維空間之特徵點比對、演化與追蹤方法	獲證	台灣	發明	科專	1321297	95136372	20100301	20260928		100%
顯示	取像與影像處理技術	133	P51980095US	一種利用影像資訊進行場景分類的方法	獲證	美國	發明	科專	8,693,769	12/648,184	20140408	20310720	曾非專屬授權	100%
顯示	取像與影像處理技術	134	P51960126TW	多視角影像的影像合成方法	獲證	台灣	發明	科專	1348120	97102185	20110901	20280120		100%
顯示	取像與影像處理技術		P51960126US	多視角影像的影像合成方法	獲證	美國	發明	科專	8,218,854	12/126,936	20120710	20301126		100%
顯示	取像與影像處理技術	135	P51990058TW	影像處理的方法及裝置	獲證	台灣	發明	科專	1462053	99145926	20141121	20301223	曾非專屬授權	100%
顯示	取像與影像處理技術		P51990058US	影像處理的方法及裝置	獲證	美國	發明	科專	8,754,891	13/152,093	20140617	20320826	曾非專屬授權	100%
顯示	取像與影像處理技術	136	P08940084TW	三維人臉辨識系統及其方法	獲證	台灣	發明	科專	1318756	94147174	20091221	20251228		100%

技術類別	子分類	案號	件編號	專利中文名稱	狀態	國家	類別	歸屬	公告號	申請號	專利起期	專利迄期	備註	本案讓與專利權比例
顯示	取像與影像處理技術		P08940084US	三維人臉辨識系統及其方法	獲證	美國	發明	科專		11/450,581	2009 1117	2028 0623		100%
顯示	取像與影像處理技術	137	P51980096TW	姿勢辨識方法與系統,及其電腦程式產品	獲證	台灣	發明	科專	I408610	98145756	2013 0911	2029 1229	曾非專屬授權	100%
顯示	取像與影像處理技術		P51980096US	姿勢辨識方法與系統,及其電腦程式產品	獲證	美國	發明	科專	8,417,026	12/813,464	2013 0409	2031 0817		100%
顯示	取像與影像處理技術		P51980096CN	姿勢辨識方法與系統,及其計算機程序產品	獲證	中國	發明	科專	102136070	201010105189.2	2013 1030	2030 0121		100%
顯示	取像與影像處理技術	138	P51990074TW	追蹤目標物的方法及裝置	獲證	台灣	發明	科專	I394087	99147243	2013 0421	2030 1230	曾非專屬授權	100%
顯示	取像與影像處理技術		P51990074US	追蹤目標物的方法及裝置	獲證	美國	發明	科專	8,442,269	13/066,515	2013 0514	2031 0802	曾非專屬授權	100%
顯示	取像與影像處理技術	139	P51950110TW	影像填補方法及其機器可讀取媒體	獲證	台灣	發明	科專	I324756	95143135	2010 0511	2026 1121		100%
顯示	取像與影像處理技術	140	P51950175TW	解決遮蔽主體影像之三維擬真貼圖模型建構的方法	獲證	台灣	發明	科專	I331731	95149329	2010 1011	2026 1226		100%
顯示	取像與影像處理技術	141	P51960125TW	重建三維模型的方法	獲證	台灣	發明	科專	I346309	96149283	2011 0801	2027 1220		100%
顯示	取像與影像處理技術		P51960125US	重建三維模型的方法	獲證	美國	發明	科專	8,081,183	12/106,351	2011 1220	2030 1019		100%

【備註】：本標案公告所包含之專利範圍除專利清單明載外，包含上開專利之延續案、分割案、EPC 申請案指定 國別後所包含之各國專利、PCT 同一案所申請之各國專利。